



SCHWEIZERISCHE Eidgenossenschaft  
EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

(11) CH 708 735 A8

(51) Int. Cl.: C23C 24/04 (2006.01)  
F01D 5/18 (2006.01)

**Patentanmeldung für die Schweiz und Liechtenstein**

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

(12) **PATENTANMELDUNG**

(15) Korrekturinformation:  
**Korrigierte Fassung Nr. 2**  
INID code(s) 72

(21) Anmeldenummer: 01751/14

(22) Anmeldedatum: 11.11.2014

(43) Anmeldung veröffentlicht: 29.05.2015

(30) Priorität: 22.11.2013 US 14/087,897

(48) Berichtigung veröffentlicht: 30.09.2015

(71) Anmelder:  
General Electric Company, 1 River Road  
Schenectady, New York 12345 (US)

(72) Erfinder:  
Ronald Scott Bunker, Cincinnati, OH 45215 (US)  
Luc Stephane Leblanc, Niskayuna, NY 12309 (US)  
Leonardo Ajdelsztajn, Niskayuna, NY 12309 (US)

(74) Vertreter:  
R.A. Egli & Co, Patentanwälte, Baarerstrasse 14  
6300 Zug (CH)

(54) **Verfahren zur Bildung von Kanälen auf einem metallischen Substrat.**

(57) Es ist ein Verfahren zur Bildung von Kanälen (46) auf einem metallischen Substrat (30) beschrieben. Das Verfahren enthält die Schritte des Aufbringens wenigstens einer Schicht (34, 36, 44) aus einem metallischen Beschichtungsmaterial auf eine Oberfläche des Substrates (30) mittels einer Kaltspritztechnik, um Grenzwände (48) für die Kanäle (46) zu definieren und die Grenzwände (48) bis zu einer gewünschten Höhe aufzubauen. Dann wird zusätzliches Beschichtungsmaterial (50) auf eine oder mehrere Oberflächen der Grenzwände (48) mittels der Kaltspritztechnik aufgebracht, um so die Gestalt der Kanäle (46) zu modifizieren. Das Substrat (30) kann eine Hochtemperaturkomponente oder Heissgaspfadkomponente einer beliebigen Bauart sein. In einigen Fällen ist das Substrat eine Gasturbinenwand.

